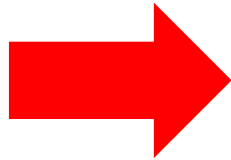


Fette possibili

- Epi
- Si to Si

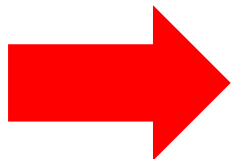


Si HR

Zona di transizione

Silicio bulk

- SOI



Si HR

Si fortemente drogato boro

Ossido di silicio

Silicio bulk

Tipologia fette tipo p

Si to Si	100um	>5K	<100>
Si- Si	130um	>5K	<100>
SOI	130um	>5K	<100>

ossido tra fetta e supporto di 1-2um

epi	130um	circa 1K	<100>
-----	-------	----------	-------

- fetta di processo è una Fz mentre il supporto è Cz con resistività minore dell' Ohm, lo spessore della parte Cz non è rilevante : basta che lo spessore totale (Fz+fetta supporto) sia compreso tra 500 e 675um.

Richieste a ...

- Okmetic **NO**
- Topsil **NO 100 ohm cm**
- MEMC **nessuna risposta dopo un iniziale si**
- Siltronic **min 300 pezzi , prezzo ?**
- shinetsu **in attesa**
- Sumikamaterials **NO**
- SUMCO **in attesa**
- Shinetsu **in attesa**
- SIMAT **trattativa per epi e SOI**
- Icmos **SOI e SI to Si**

Item	Icemos Part No.	Description	Quantity	Price in US Dollars
1	1000.380701	FBK 011 150mm SOI 500um/2um/150um Boron Buried implant.	10 wafers	\$595
2	1000.380701	FBK 011 150mm SOI 500um/2um/150um Boron Buried implant.	25 wafers	\$525
3		Per Shipment		\$195
Leadtime for the above parts = 8 - 12 weeks a.r.o				

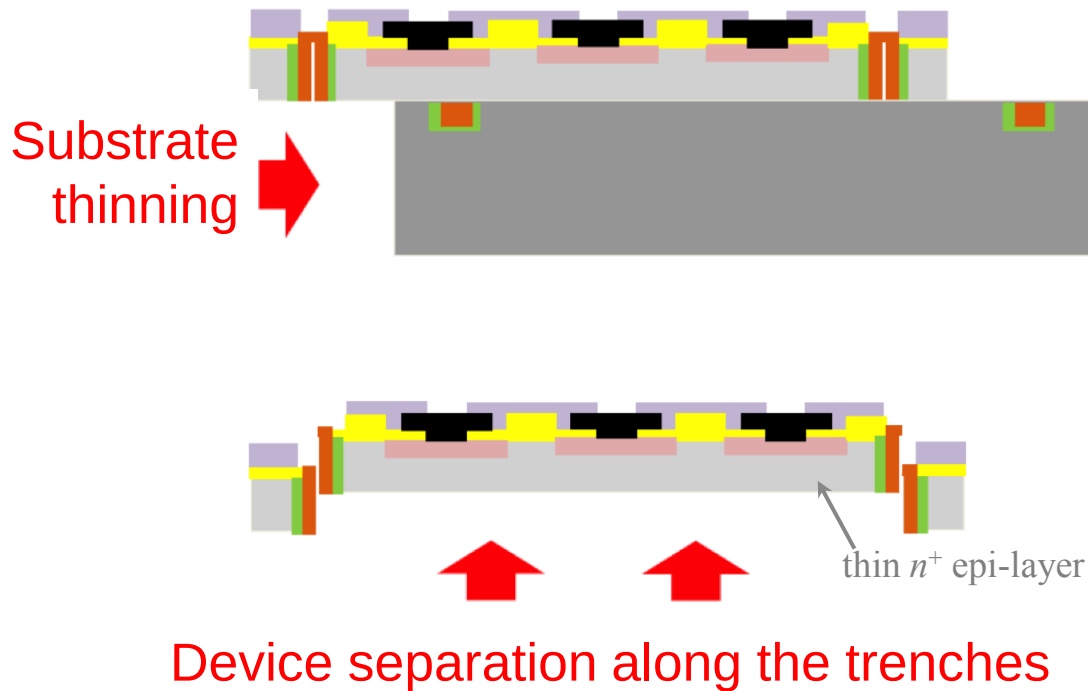
Item	Icemos Part No.	Description	Quantity	Price in US Dollars
1	1000.377001	Si Si 100um Device 400um Handle.	10 wafers	\$395
2	1000.377001	Si Si 100um Device 400um Handle.	25 wafers	\$365
3		Per Shipment		\$195

- Leadtime for the above parts = 8 - 12 weeks a.r.o

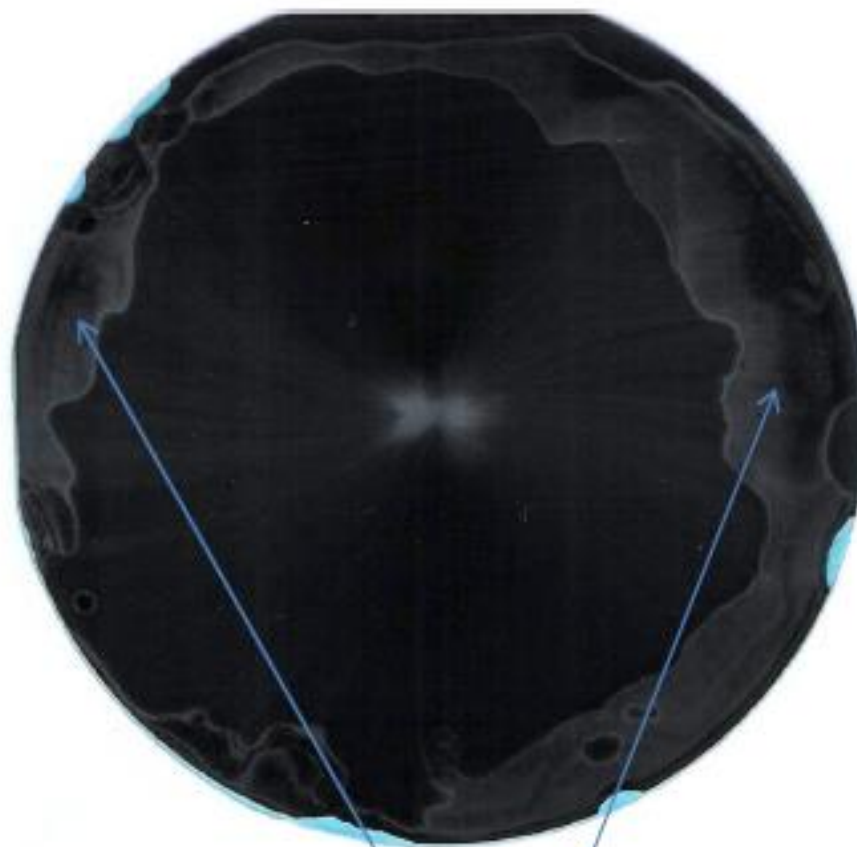
SIMAT

- Due questioni:
 - Diffusione dal bulk verso l'epi
 - Out diffusione verso il «gas» nella fase di deposizione
- Richiesto a SIMAT
 - 130um di epi a 1Kohm (spessore epi 200 um)
 - Profilo del drogaggio nell'epi
 - Offerta per SOI

Thin & Edgeless Sensor



FBK_164-09_3D Dummy_backside_target thickness 510 μ m,
no trenches visible



Remaining oxide layer?